



## CM2N60CS N 沟道 VDMOS

### \* 主要用途：

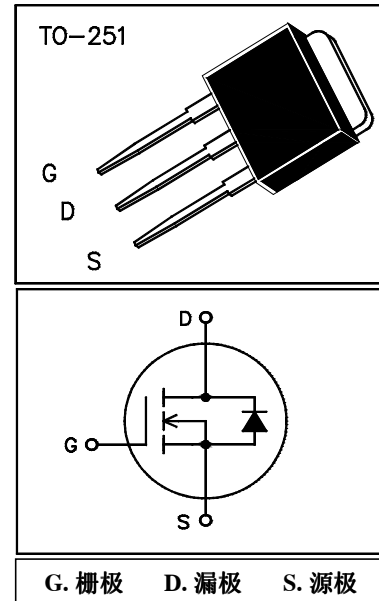
- ◆ 主要用于电源适配器、线性放大和功率开关电路

### \* 主要特点：

- ◆ 通态电阻小，输入电容小
- ◆ 开关速度快
- ◆ 100% 雪崩能量测试

### \* 注意：

- ◆ 防静电



G. 栅极 D. 漏极 S. 源极

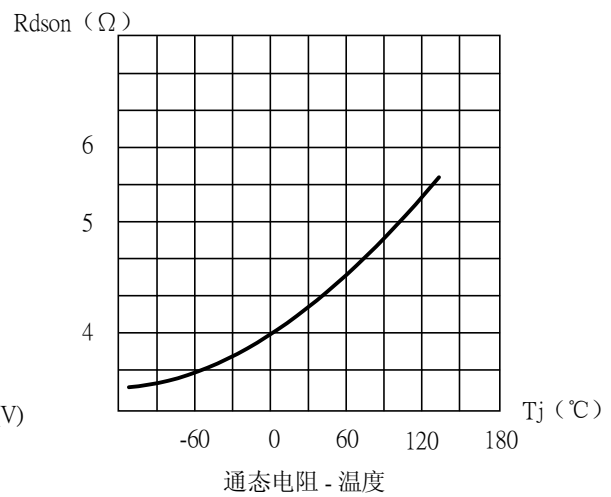
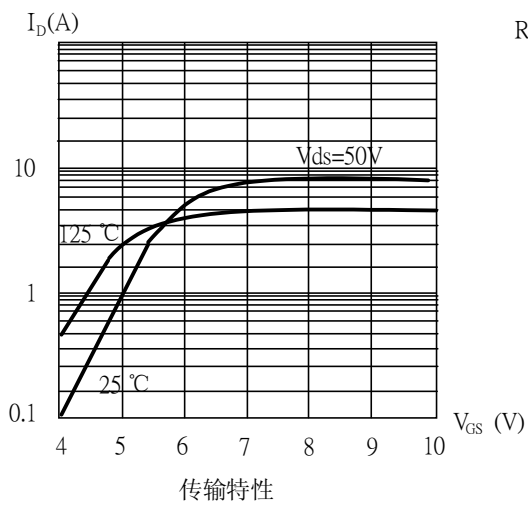
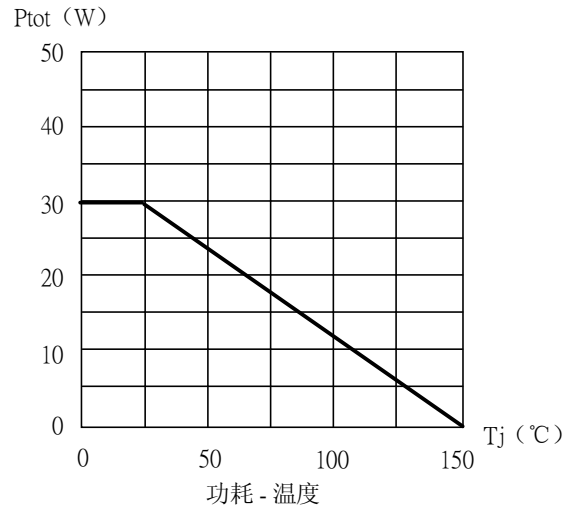
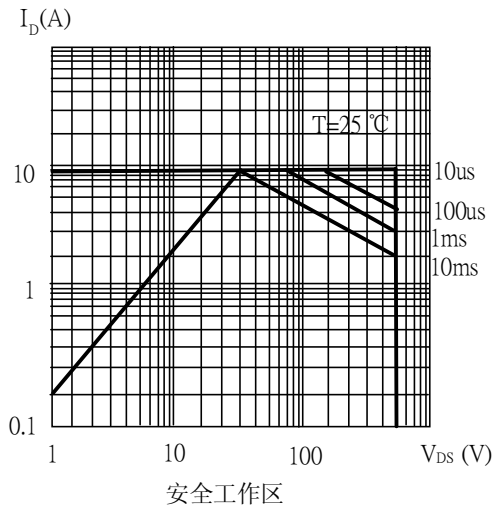
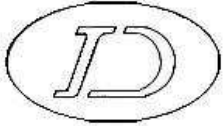
极限值：(Tc=25℃)

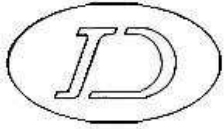
| 参数名称    | 符号              | 额定值       | 单位  |
|---------|-----------------|-----------|-----|
| 连续漏极电流  | $I_D$           | 1.5       | A   |
| 栅源电压    | $V_{GS}$        | $\pm 30$  | V   |
| 雪崩电流    | $I_{AR}$        | 1.6       | A   |
| 热阻(结到壳) | $R_{\theta JC}$ | 2.5       | ℃/W |
| 耗散功率    | $P_{tot}$       | 30        | W   |
| 结温      | $T_{jm}$        | 150       | ℃   |
| 贮存温度    | $T_{stg}$       | -55 ~ 150 | ℃   |

电特性：(Tc=25℃)

| 参数名称   | 符号           | 测试条件   | 最小值 | 典型值 | 最大值       | 单位       |
|--------|--------------|--|-----|-----|-----------|----------|
| 漏源反向电压 | $V_{DS}$     | $V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$                                | 600 |     |           | V        |
| 通态电阻   | $R_{DS(on)}$ | $V_{GS}=10V, I_D=0.5A$                                   |     |     | 10        | $\Omega$ |
| 阈值电压   | $V_{GS(th)}$ | $V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$                            | 2   |     | 4         | V        |
| 跨导     | $g_{fs}$     | $V_{DS}=50V, I_D=0.5A$                                   | 0.5 |     |           | S        |
| 漏源漏电流  | $I_{DSS}$    | $V_{DS}=600V, V_{GS}=0V$                                 |     |     | 25        | $\mu A$  |
| 栅源漏电流  | $I_{GSS}$    | $V_{GS}=\pm 30V$   |     |     | $\pm 100$ | nA       |
| 关断延迟时间 | $t_d(off)$   | $V_{DD}=250V, I_D=2.0A$<br>$R_G=18\Omega, R_D=150\Omega$ |     | 20  |           | nS       |
| 输入电容   | $C_{iss}$    | $V_{GS}=0V, V_{DS}=25V$<br>$f=1.0MHz$                    |     | 229 |           | pF       |

a: 脉冲测试:  $t_p \leq 300\mu s, \delta \leq 2\%$





## 封装形式:

**TO-251** (单位: mm, 无其他特别说明公差  $\pm 0.1\text{mm}$ )

